

# TRANSISTOR (PNP)

**BC807-16**

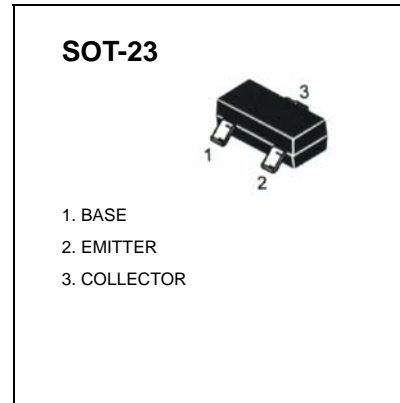
**BC807-25**

**BC807-40**

## FEATURES

- Ideally suited for automatic insertion
- epitaxial planar die construction
- complementary NPN type available(BC817)

**MARKING: 807-16:5A; 807-25:5B; 807-40:5C**



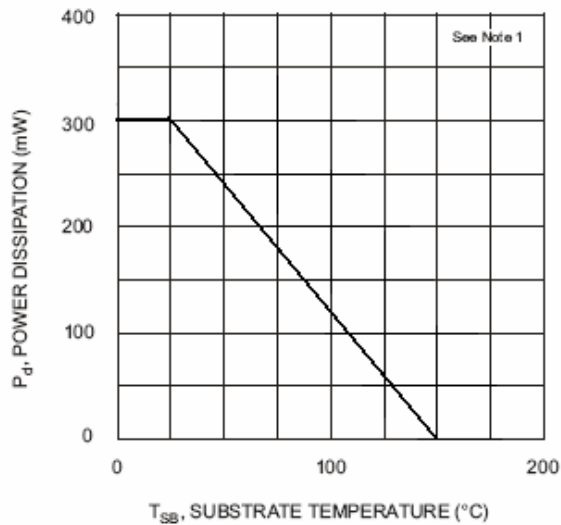
## MAXIMUM RATINGS (T<sub>A</sub>=25°C unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Value	Units
V <sub>CBO</sub>	Collector-Base Voltage	-50	V
V <sub>CEO</sub>	Collector-Emitter Voltage	-45	V
V <sub>EBO</sub>	Emitter-Base Voltage	-5	V
I <sub>C</sub>	Collector Current -Continuous	-0.5	A
P <sub>C</sub>	Collector Power Dissipation	0.3	W
T <sub>j</sub>	Junction Temperature	150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature	-55-150	°C

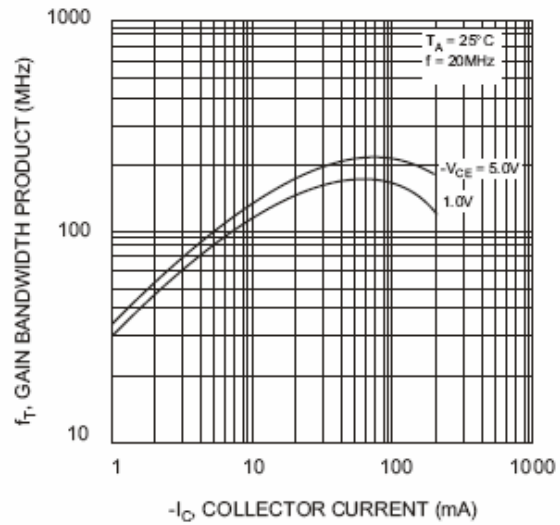
## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>amb</sub>=25°C unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	MAX	UNIT
Collector-base breakdown voltage	V <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> = -10 μ A, I <sub>E</sub> =0	-50		V
Collector-emitter breakdown voltage	V <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> = -10mA, I <sub>B</sub> =0	-45		V
Emitter-base breakdown voltage	V <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> = -1 μ A, I <sub>C</sub> =0	-5		V
Collector cut-off current	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = -45V, I <sub>E</sub> =0		-0.1	μ A
Collector cut-off current	I <sub>CEO</sub>	V <sub>CE</sub> = -40V, I <sub>B</sub> =0		-0.2	μ A
Emitter cut-off current	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = -4 V, I <sub>C</sub> =0		-0.1	μ A
DC current gain	h <sub>FE(1)</sub>	V <sub>CE</sub> = -1V, I <sub>C</sub> = -100mA	807-16	100	250
			807-25	160	400
			807-40	250	600
Collector-emitter saturation voltage	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-500mA, I <sub>B</sub> = -50mA		-0.7	V
Base-emitter saturation voltage	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -500mA, I <sub>B</sub> = -50mA		-1.2	V
Transition frequency	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = -5V, I <sub>C</sub> = -10mA f=100MHz	100		MHz

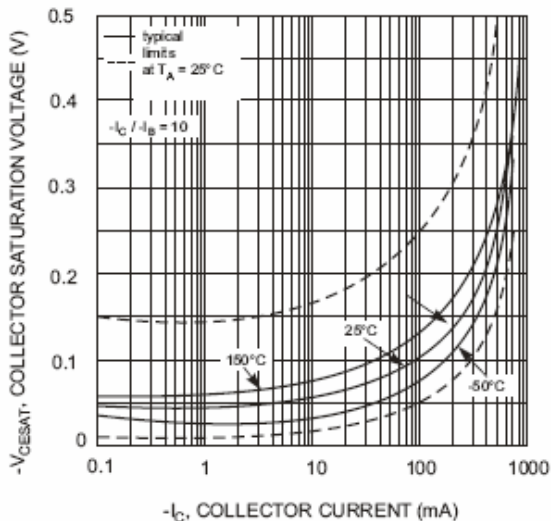
# Typical Characteristics



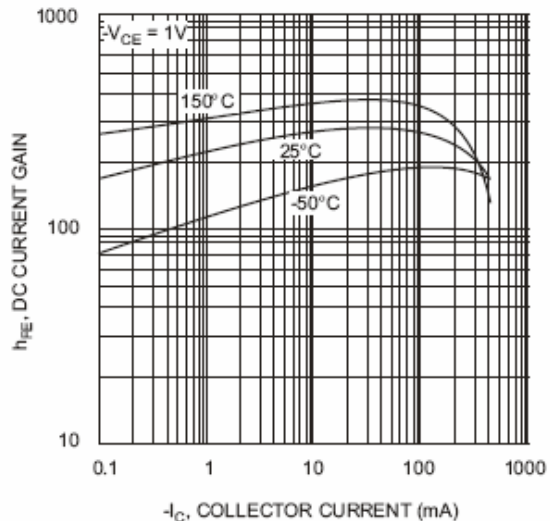
$T_{SB}$ , SUBSTRATE TEMPERATURE (°C)  
Fig. 1, Power Derating Curve



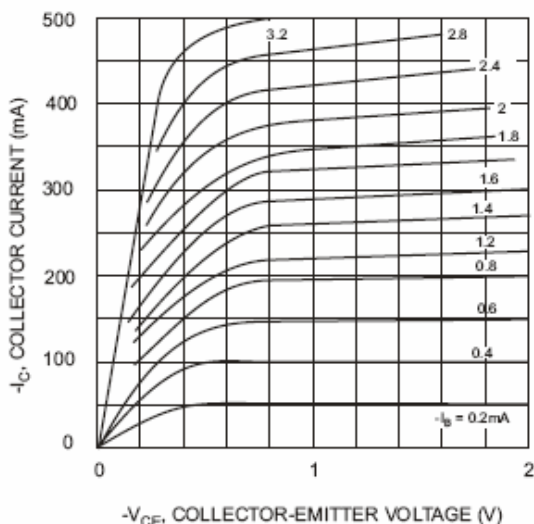
$-I_C$  COLLECTOR CURRENT (mA)  
Fig. 2, Gain-Bandwidth Product vs Collector Current



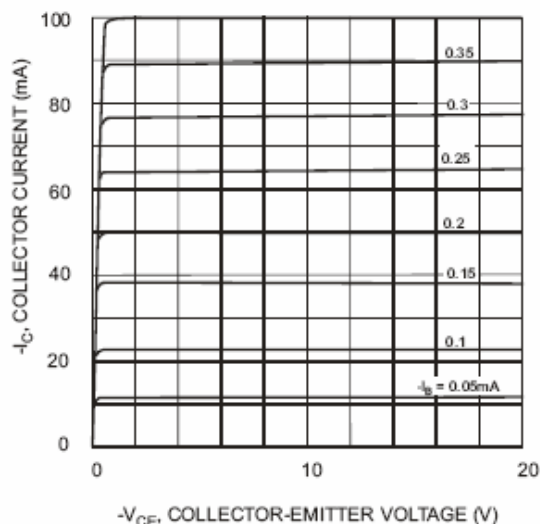
$-I_C$  COLLECTOR CURRENT (mA)  
Fig. 3, Collector Sat Voltage vs Collector Current



$-I_C$  COLLECTOR CURRENT (mA)  
Fig. 4, DC Current Gain vs Collector Current



$-V_{CE}$ , COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V)  
Fig. 5, Typical Emitter-Collector Characteristics



$-V_{CE}$ , COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V)  
Fig. 6, Typical Emitter-Collector Characteristics



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331